



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HC4468

对应国外型号
2SC4468

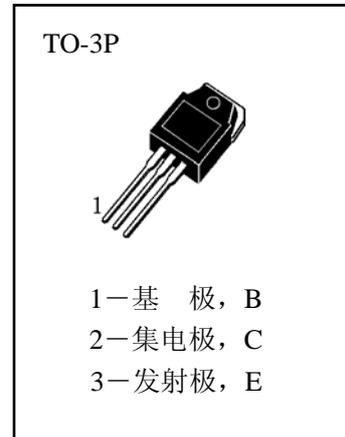
■ 主要用途

音频功率放大。与 HA1695 互补。

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg}	— 贮存温度	-55~150 $^\circ\text{C}$
T_j	— 结温	150 $^\circ\text{C}$
P_C	— 集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	100W
V_{CBO}	— 集电极—基极电压	200V
V_{CEO}	— 集电极—发射极电压	140V
V_{EBO}	— 发射极—基极电压	6V
I_C	— 集电极电流 (DC)	10A
I_B	— 基极电流	4A

■ 外形图及引脚排列



■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	200			V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	140			V	$I_C=50\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{CB}=200\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	$V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	50		180		$V_{CE}=4\text{V}, I_C=3\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	$I_C=5\text{A}, I_B=0.5\text{A}$
f_T	特征频率		20		MHz	$V_{CE}=12\text{V}, I_E=-0.5\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		250		pF	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$

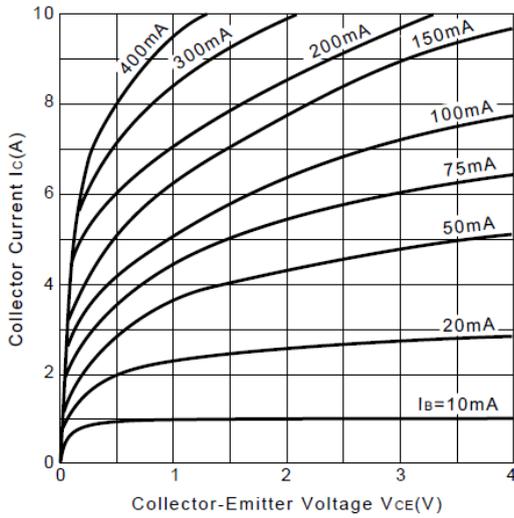
■ HFE (1) 分档及其标志

0	P	Y
50—100	70—140	90—180

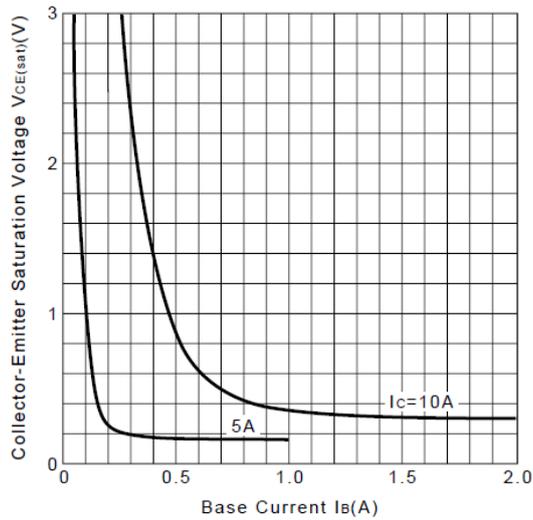


典型特性曲线

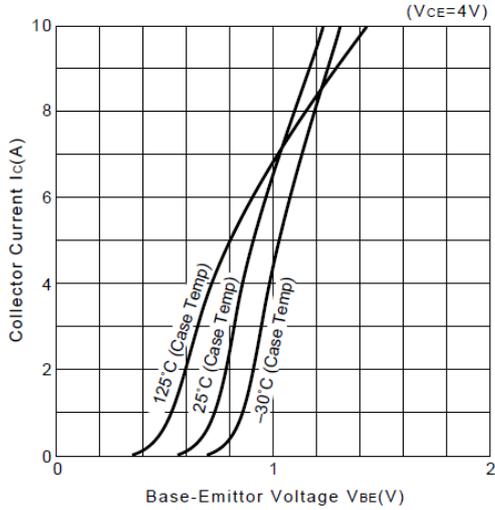
I_C-V_{CE} Characteristics (Typical)



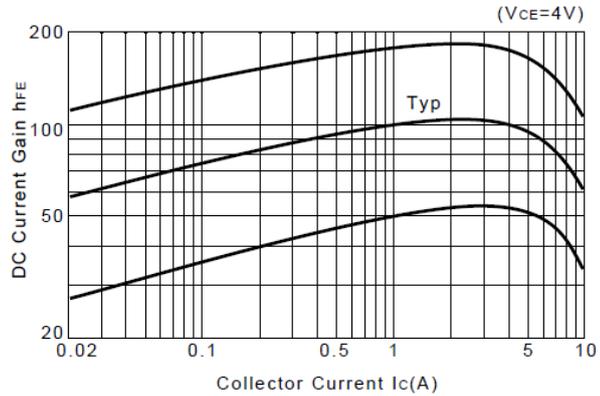
$V_{CE(sat)}-I_B$ Characteristics (Typical)



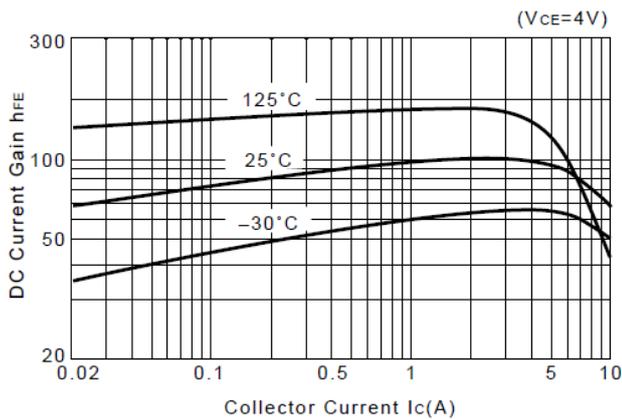
I_C-V_{BE} Temperature Characteristics (Typical)



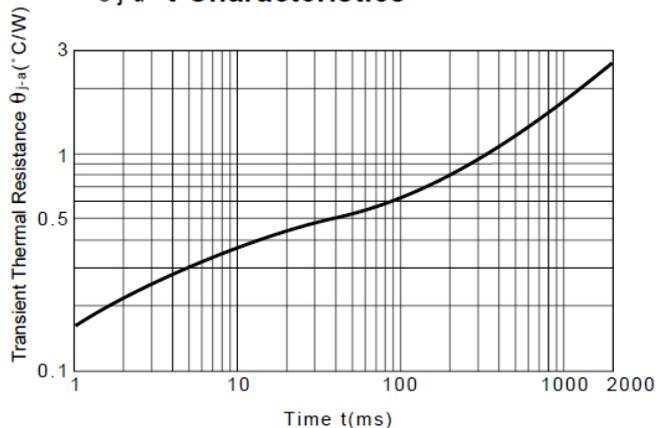
$h_{FE}-I_C$ Characteristics (Typical)



$h_{FE}-I_C$ Temperature Characteristics (Typical)



$\theta_{j-a}-t$ Characteristics





汕头华汕电子器件有限公司

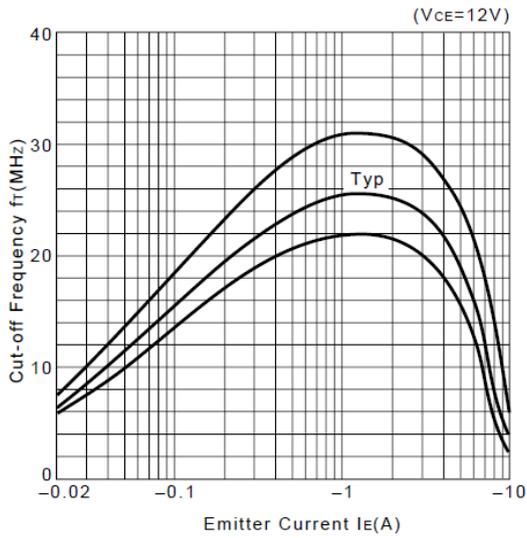
NPN SILICON TRANSISTOR

HC4468

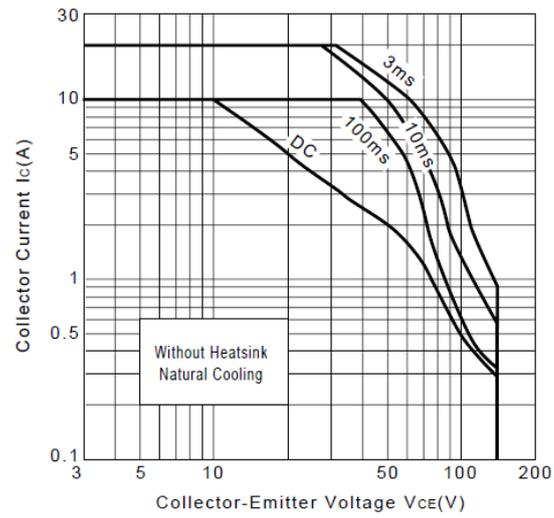
对应国外型号
2SC4468

典型特性曲线

f_T - I_E Characteristics (Typical)



Safe Operating Area (Single Pulse)



P_C - T_a Derating

